



## **NDTCS-2017**

### **17<sup>th</sup> International Workshop on New Approaches to High-Tech: Nano-Design, Technology, Computer Simulations**

#### **Открытие семинара**

Семинар проводится уже в 17-й раз, каждый раз в разных городах и странах. В этом году для проведения семинара была выбрана наша страна, наш университет и наша кафедра. Организаторами семинара является Министерство образования Республики Беларусь и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Спонсором семинара является акционерное общество «ИНТЕГРАЛ».

Вступительное слово и право открыть семинар предоставлено проректору по научной работе БГУИР Осипову А.Н.



В президиуме семинара (слева направо) А.Мелкер, сопредседатель Академия наук Россия, Санкт-Петербург, А.Н.Осипов, А.Белоус АО»Интеграл», В.Р.Стемпицкий сопредседатель БГУИР, каф.МиНЭ.

Он поздравил всех присутствующих с началом семинара, особенно отметил молодежный состав и важность этого для развития микро- и наноэлектроники.

Далее слово предоставили профессору, член-корреспонденту НАН РБ, зам.АО «Интеграл» Белоусу А.И.



Он отметил важность проводимого семинара для продвижения инновационных разработок и их практического применения, а также привлечения молодых сотрудников для работы на АО «Интеграл». Пусть семинару сопутствует успех.

В зале собралась большая и представительная аудитория. С интересом и вниманием присутствующие слушают выступления докладчиков.





Об истории развития и перспективах современной микро- и нанoeлектроники рассказал следующий докладчик академик НАН РБ, зарубежный член АН России, академик профессор Лабунов В.А.



В настоящее время в микро- и нанoeлектронике наметилось несколько направлений это дальнейшее развитие существующей кремниевой технологии с уменьшением топологических норм, разработка 10-нм технологии FinFET, транзистора с трехмерной (3D) структурой затвора (Tri-Gate) и возможность серийного производства этих устройств. Еще одно

направление – это моделирование устройств с использованием графена, углеродных нанотрубок, а также халькогенидов переходных металлов, как альтернативы кремнию. И, наконец, искусственный интеллект. И здесь очень важным является моделирование технологических процессов создания таких структур. Наша страна имеет специалистов высокого уровня в области компьютерного моделирования и проектирования самых современных устройств. За молодыми учеными, нынешними аспирантами, студентами будущее. Привлечь молодежь к таким разработкам – важная задача. Семинары, конференции, контакты с ведущими специалистами помогут в этом.

